

Diodos aplicados à sensores digitais de imagem

Leandro Assis dos Santos

10 de março de 2022

Introdução

Sensores digitais de imagem são sensores que transduzem a intensidade luminosa incidente sobre eles em sinais elétricos analisáveis por um sistema computacional. Esses sensores são usados em imagens eletrônicas aplicadas a diversos dispositivos como câmeras digitais, mouses ópticos, equipamentos de imagem médica, equipamentos de visão noturna e térmica, LIDARs (Light Detection and Ranging), dentre outros.

Os sensores de imagem são feitos de fótodiodos, que é um tipo de diodo construído de forma a possibilitar a utilização da incidência de luz como fator determinante no controle da corrente elétrica, e um ou mais transistores ativos. Ou seja, os fótons incidentes sobre o sensor interagem com o fótodiodo para mover elétrons de forma proporcional ao aumento da intensidade luminosa no cristal, juntamente a isso os transistores atuam de forma programada, como será visto mais a frente, a fim de registrar a imagem. Os sensores modernos de imagem utilizam da exploração desse efeito fotoelétrico concomitantemente da característica capacitiva que junções pn em polarização reversa (fótodiodos em polarização reversa) possuem.

Em resumo, ao polarizar um diodo reversamente com uma fonte de tensão V_R (Figura 1), o campo elétrico interno da junção pn que constitui o diodo é reforçado. Por conta disso, a barreira de potencial se fortalece e mais íons (de ambos, aceitadores e doadores) ficam expostos. Devido ao campo induzido pelo terminal negativo da fonte V_R , as lacunas da região p são atraídas para o extremo do ânodo do diodo, e de forma similar (mas por conta do campo induzido pelo terminal positivo) os elétrons são atraídos para o extremo do cátodo do diodo.

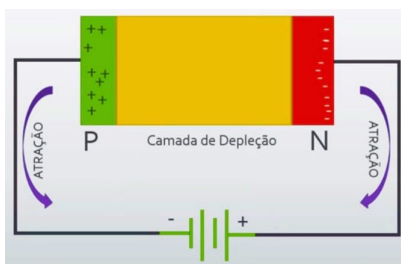


Figura 1: Diodo polarizado reversamente.

Em razão da concentração de cargas nos extremos do diodo e do aumento da barreira de potencial, isto é, o aumento da voltagem entre as extremidades da região de depleção, a região de depleção se torna mais larga e podemos pensar nos extremos do diodo como as placas de um capacitor. A junção pn portanto, quando polarizada reversamente, possui capacitância dependente de V_R .

Uma vez que possui-se o fótodiodo funcionando como um capacitor sob uma tensão reversa, o dispositivo se carregará com um

dado valor V_C que depende do tempo ao qual o fótodiodo (agora agindo como capacitor) ficou alimentado pela tensão reversa V_R . Com o fótodiodo carregado permite-se a entrada de luz sobre o sensor, que resultará em uma indução de corrente na junção pn e, conseqüentemente, em uma diminuição na tensão V_C . A partir da observação individual da tensão V_C em uma matriz de fótodiodos é possível fazer a transdução da luz incidente sobre o sensor em uma imagem.

Tipos de sensores de imagem

Os sensores de imagem podem ser separados em dois principais tipos, eles são os CCDs (*Charge-Couple Device*) e os sensores CMOS, configurações de sensores baseados em APS (*Active Pixel Sensor*), estes podendo ser classificados de acordo com o número de transistores por pixel, como por exemplo 3T-APS, 4T-APS e assim por diante. Ambos os dispositivos são feitos com tecnologia MOS (*Metal Oxide Semiconductor*), com CCDs baseados em capacitores MOS e os sensores CMOS baseados em amplificadores MOSFET. A seguir entra-se em mais detalhes sobre cada tipo de sensor, suas características, histórias, vantagens e desvantagens.

A história dos sensores de imagem

Os sensores CCDs são pioneiros no ramo de imagem digital e sua origem remonta às pesquisas com tecnologia MOS de Willard Boyle e George E. Smith. Durante a pesquisa descobriram que uma carga elétrica poderia ser armazenada em pequenos capacitores MOS, descoberta essa que se tornou a base para o sensor CCD, inventado em 1969.

Apenas em 1980 surgiu um fator chave para os sensores CMOS modernos, o fótodiodo “fixado” (do inglês PPD - Pinned Photo-Diode) inventado por Nobukazu Teranishi, Hiromitsu Shiraki e Yasuo Ishihara. O diferencial desse componente em relação aos demais é o baixo *lag*, baixo ruído, alta eficiência quântica (taxa de conversão de fótons em elétrons) e baixa corrente quando aplicado a pouca luminosidade. A partir de 1987, os PPDs começaram a ser incorporados na maioria dos sensores CCDs, e desde então são usados em todos os sensores CCD e CMOS.

Apesar dos sensores CCDs terem sido pioneiros no ramo de medição científica nos anos 80 e se tornado o sensor de escolha para praticamente toda aplicação de imagens nesta época, o desenvolvimento de sensores CMOS atingiu um ponto em que começou a substituir os sensores CCDs em aplicações de baixa performance. Com o passar do tempo os sensores de tecnologia CMOS se expandiram, enquanto os de tecnologia CCD estagnaram. De forma geral, ambos os dispositivos são utilizados de acordo com a necessidade da aplicação.

Sensores de Pixel Passivo - PPS

Os precursores dos sensores APS foram os PPS (do inglês, passive-pixel sensor), um tipo de matriz de pixels formada por fôtdiodos e uma chave MOSFET, que consiste em “pixels passivos” sem amplificação, ou seja, essa configuração de pixel transfere diretamente o sinal acumulado para fora do pixel. Nesses sensores cada pixel possui uma junção pn, capacitor integrado e transistores de seleção. Essa configuração de pixels passivos foi proposta por G. Weckler em 1968 e antecedeu a criação dos CCDs. Os PPS sofrem de diversas limitações como alto ruído, baixo tempo de leitura e dificuldade de escalabilidade. De forma geral, os sensores CCDs possuem matrizes de pixels passivos.

Sensores de Pixel Ativos - APS

Esses sensores consistem de “pixels ativos”, que consiste em um ou mais amplificadores MOSFET que convertem a carga fóto-gerada em uma tensão, amplifica o sinal de tensão e reduz o ruído. Esse conceito de pixel foi proposto por Peter Noble em 1968, entretanto esta topologia de pixels só foi fabricada a partir de 1985 devido as evoluções nos processos de fabricação dos transistores MOS. Os sensores CMOS utilizam dessa configuração de pixels para seu funcionamento, tendo como principal diferença o uso de transistores CMOS ao invés de transistores PMOS ou NMOS.

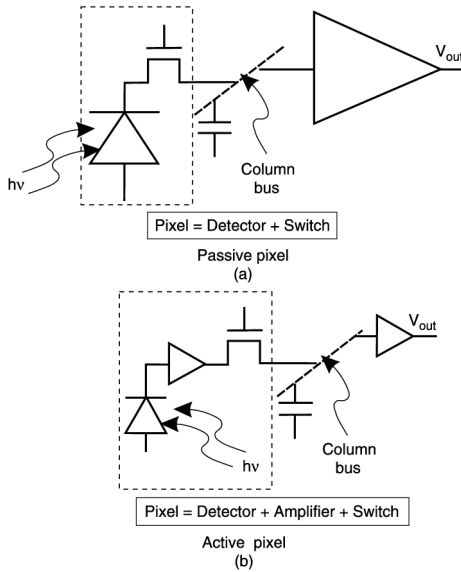


Figura 2: Apresentação das configurações de PPS (a) e APS (b).

Sensores CCD

Como dito anteriormente, os CCDs são circuitos integrados formado por pixels em matriz feitos em uma placa de silício, registradores de deslocamento analógicos e amplificadores. Esses pixels dispostos em colunas possuem um *gate* responsável por controlar o deslocamento e armazenamento de cargas através da tensão, a Figura 3 apresenta a transição de cargas de pixels de colunas adjacentes feito ao comutar o gate da coluna de destino para HIGH e da coluna de partida para LOW de forma gradativa.

Como apresentado de forma gráfica em [2], o funcionamento dos CCDs pode ser descrito, de forma análoga, como uma matriz de baldes (pixels) coletando água da chuva (fótons). Os baldes

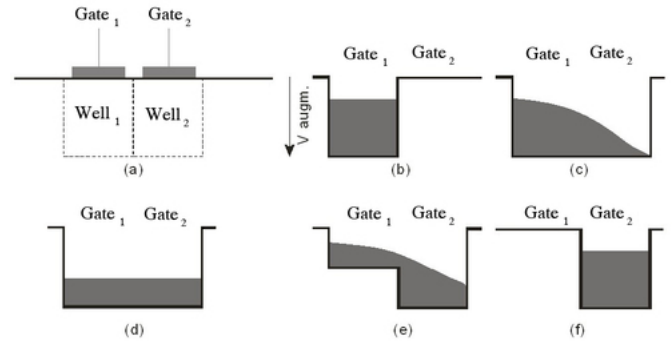


Figura 3: Fluxo de carga de pixels adjacentes.

são expostos à chuva pela mesma quantidade de tempo, e consequentemente se enchem com diferentes quantidades de água. A seguir o CCD inicia a leitura de cada balde por vez. Este processo de leitura é feito transferindo a água de cada balde, da coluna mais a esquerda para o balde adjacente em uma coluna vazia ao lado. Essa coluna anteriormente vazia desloca um de seus baldes para baixo por vez, onde se encontra um conversor que reconhece e armazena o nível d'água. Ou seja, há um deslocamento horizontal dos “baldes” de uma coluna para “baldes de outra, e posteriormente um deslocamento vertical de um “balde” por vez na coluna de saída.

Na prática, como apresentado na Figura 4, o fôtdiodo polarizado reversamente de cada pixel é exposto aos fótons incidentes sobre o sensor. Devido ao fluxo de fótons sobre o fôtdiodo, elétrons são liberados - proporcionalmente a intensidade e cor da luz - e, consequentemente, lacunas são criadas na estrutura cristalina. Ou seja, há um fluxo de corrente induzido no fôtdiodo agindo como capacitor. Inicialmente, esses elétrons ficam desprendidos na camada de depleção, mas posteriormente são concentrados na parte N+ do fôtdiodo por conta do potencial positivo que é induzido nesta parte apenas durante a leitura.

Através do acionamento do transistor de seleção pela entrada SEL as cargas na coluna mais próxima ao amplificador (COL_j) são deslocadas para um registrador de deslocamento, que será responsável por transferir a carga de um pixel da coluna por vez para a saída. Devido ao acionamento do transistor de seleção - que age como o *gate* descrito anteriormente-, após as cargas da coluna serem transferidas para a saída, as cargas nas colunas anteriores (COL_{j-1} , COL_{j-2} , e assim por diante) são deslocadas para as colunas posteriores (COL_j , COL_{j+1} , e assim por diante). O processo segue em *loop* até que todas as linhas e colunas tenham sido iteradas. A leitura das cargas no CCD pode ser feita de forma mais rápida ao construir o CCD com amplificadores em cada vértice da matriz de pixels, e adicionar registradores de deslocamento em cada aresta.

Após o processo, afim de preparar os pixels do CCD para uma nova leitura, o transistor de *reset* é acionado pela entrada RST, e todos os *gates* são levados à nível lógico alto - entrada SEL acionada para todas os pixels - por um período de tempo, fazendo com que os fôtdiodos de cada pixel voltem para o estado inicial e fiquem prontos para um novo processo.

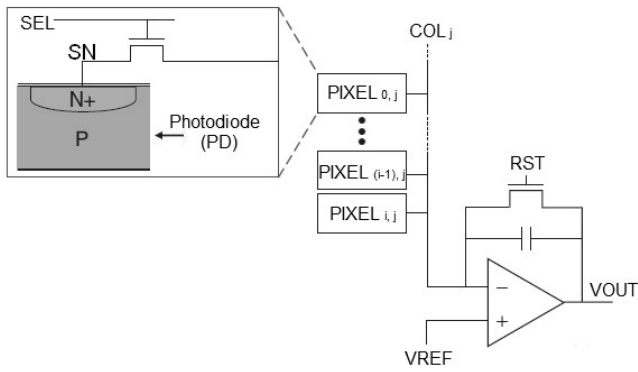


Figura 4: Array simplificada de um CCD.

Sensores CMOS

Assim como os CCDs, os sensores CMOS são dispositivos capazes de transduzir os fótons incidentes em energias elétricas. A partir de 2010 esses sensores substituíram grande parte se não todos os CCDs, por conta das vantagens que este dispositivo tem sobre os CCD. Os sensores CMOS também são constituídos de matrizes de pixels feitos em uma placa de silício. A grande diferença na arquitetura desses dispositivos é que utilizar a configuração APS - ao invés da PPS, como os CCDs -, ou seja, possuem amplificação interna em cada pixel. A seguir, na figura 5, é apresentado um pixel simplificado de um sensor CMOS-3T (3T é devido aos 3 transistores presentes no pixel).

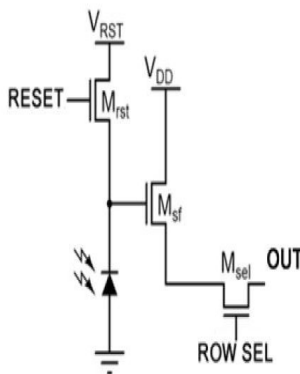


Figura 5: Pixel CMOS 3T.

O princípio de funcionamento dos sensores CMOS é de certa forma mais simples que os CCDs. O fotodiodo polarizado reversamente que funciona como um capacitor armazena a tensão V_{RST} ao acionar o transistor MOSFET M_{rst} através da adição de nível HIGH na entrada RESET durante o intervalo de *reset*. Ao levar o nível da entrada RESET para LOW, o fotodiodo é deixado flutuando e os fótons incidentes sobre a junção pn induzem uma corrente que descarrega a tensão armazenada e, consequentemente, altera a tensão no *gate* do transistor M_{sf} , que atua como amplificador *source follower*, resultando em uma variação na tensão -submúltiplo de V_{DD} proporcional a tensão no gate do MOSFET- que chega ao transistor de seleção M_{sel} . O período de tempo após desligar o transistor M_{rst} , onde é analisada a flutuação de tensão no fotodiodo, é chamado tempo de integração.

Após o tempo de integração, acionando o transistor M_{sel} através da entrada ROW SEL, uma corrente flui de VDD para OUT

pelos transistores M_{sel} e M_{sf} , e a tensão no cátodo do fotodiodo pode ser lida na saída do pixel. A leitura de cada pixel organizada em matrizes é feita linha a linha através do acionamento do M_{sel} correspondente e impondo a corrente em cada coluna. Antes de iniciar um novo ciclo de leitura, um novo tempo de *reset* é distribuído linha a linha, ou em todos os pixels ao mesmo tempo após a leitura de toda a matriz. Ao resetar todos os fotodiodos ao mesmo tempo, evitam-se distorções de imagens. É interessante observar que, diferentemente dos CCDs, os sensores CMOS podem ler várias colunas ao mesmo tempo desde que as colunas não compartilhem a mesma saída de dados para processamento no circuito integrado.

Diferentes configurações de sensores CMOS podem ser obtidas adicionando mais transistores para contemplar novas funções. Por exemplo, os CMOS-4T possuem um transistor de transferência M_{tx} localizado entre o fotodiodo e o *gate* do transistor M_{sf} , e um nó FD localizado no encontro do *gate* de M_{sf} , *source* de M_{tx} e *drain* de M_{rst} . A operação dessa configuração é praticamente a mesma que o CMOS-3T, mas com o transistor de transferência seccionando - M_{tx} desligado, com nível LOW no *gate*- inteiramente o fotodiodo durante a flutuação de tensão na captura de fótons, e ineligando-o durante a transferência de cargas para o *source follower* e o *reset*. A adição desses novos componentes a estrutura resultam em uma transferência de carga do fotodiodo para a saída OUT com menos ruído.

Outras funções como linhas compartilhadas, 4 e 8 caminhos compartilhados para a leitura mais rápida, aumento da densidade de pixels, ou correção de distorções como *rolling shutter* podem ser adicionadas ao aumentar o número de transistores e/ou empregar outras arquiteturas, adicionando componentes como capacitores.

CCD vs. CMOS

É possível comparar a eficiência desses dois tipos de sensores ao comparar alguns parâmetros como integração de sistemas,

Por conta do uso de PPS (*Passive Pixels Sensores*), não é possível integrar dispositivos como *timers* e conversores A/D diretamente na matriz de pixels, sendo necessário adicionar *chips* periféricos para realizar essas funções, o que resulta em um tamanho maior para os circuitos integrados CCDs.

Simulação de um sensor CMOS simplificado

Fazer quinta To do: Focar em uma análise mais quantitativa, com equações e etc

1 Extra: Cores em imagens

fazer quinta

Referências

- [1] Mazin H.; Saad D. Design and simulation of a CMOS image sensor with a built-in edge detection for tactile vision sensory substitution, **AIMS Electronics and Electrical Engineering**. DOI: 10.3924/ElectrEng.2019.2.144, 06 May 2019.

- [2] Spectral Instruments, Inc. What is a CCD?, Disponível em: <https://specinstcameras.com/what-is-a-ccd/>, 2021. Acesso em: 07 mar 2022.
- [3] IMAGE sensor. In:WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2006. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Image_sensor Acesso em: 07 mar 2022.
- [4] ACTIVE-pixel sensor. In:WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2006. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Active-pixel_sensor Acesso em: 04 mar 2022.
- [5] Meroli, Stefano, Design and implementation of Active Pixel Sensors (APS), Disponível em: https://meroli.web.cern.ch/lecture_activepixelsensors.html. Acesso em: 07 mar 2022.
- [6] Computerphile, Capturing Digital Images (The Bayer Filter) - Computerphile. Youtube, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LWxu4rkZBLw>. Acesso em: 07 mar 2022.
- [7] ALL ABOUT ELECTRONICS, Image Sensors Explained: How CCD and CMOS Sensors works? CCD vs CMOS. Youtube, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FKJFIzDfUNE&t=421s>. Acesso em: 05 mar 2022.
- [8] Hodgins, Sean, I Made My Own Image Sensor! (And Digital Camera). Youtube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PaXweP73NT4>. Acesso em: 03 mar 2022.